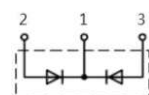


JXCCS30S1 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S1

$$I_{F(AV)} : 1A$$

$$V_{RMM} \geq 30V$$

$$V_F \leq 0.43V$$

电特性:

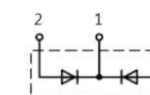
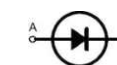
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.55	V	@1A, $T_J = -55^\circ C$
		0.43		@1A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	70	uA	$V_R = 30V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 30V T_J = 125^\circ C$

JXCCS30S2 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S2

$$I_{F(AV)} : 2A$$

$$V_{RMM} \geq 30V$$

$$V_F \leq 0.4V$$

电特性:

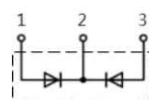
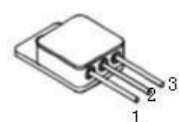
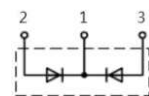
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.55	V	@2A, $T_J = -55^\circ C$
		0.44		@2A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	250	uA	$V_R = 30V T_J = 25^\circ C$
		1000		$V_R = 30V T_J = 125^\circ C$

JXCCS30S3 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S3

$$I_{F(AV)} : 3A$$

$$V_{RMM} \geq 30V$$

$$V_F \leq 0.49V$$

电特性:

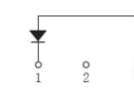
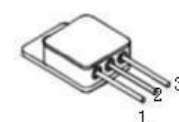
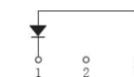
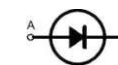
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.6	V	@3A, $T_J = -55^\circ C$
		0.49		@3A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	300	uA	$V_R = 30V T_J = 25^\circ C$
		1000		$V_R = 30V T_J = 125^\circ C$

JXCCS30S15 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S15

$$I_{F(AV)} : 15A$$

$$V_{RMM} \geq 30V$$

$$V_F \leq 0.51V$$

电特性:

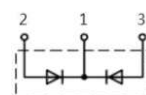
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@15A, $T_J = -55^\circ C$
		0.51		@15A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	90	uA	$V_R = 30V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 30V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S1 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S1

$$I_{F(AV)} : 1A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.4V$$

电特性:

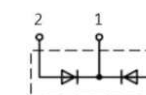
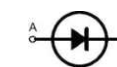
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.55	V	@ 1A, $T_J = -55^\circ C$
		0.4		@ 1A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S3 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S3

$$I_{F(AV)} : 3A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.6V$$

电特性:

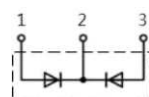
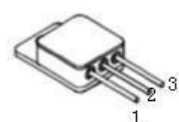
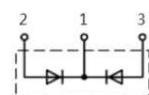
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.7	V	@ 3A, $T_J = -55^\circ C$
		0.6		@ 3A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	20	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S5

$$I_{F(AV)} : 5A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.54V$$

电特性:

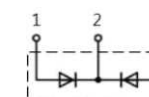
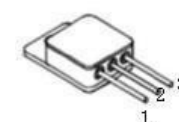
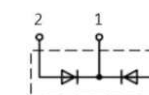
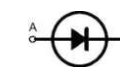
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@5A, $T_J = -55^\circ C$
		0.54		@5A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	20	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S10

$$I_{F(AV)} : 5A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.54V$$

电特性:

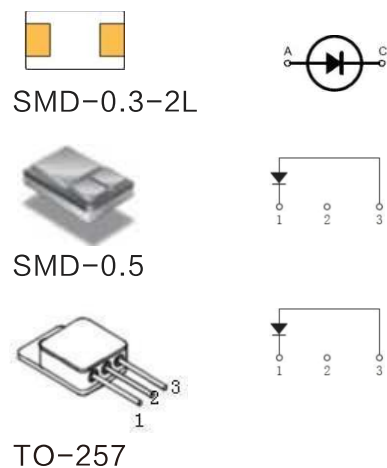
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@5A, $T_J = -55^\circ C$
		0.54		@5A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	20	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S15 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S15

$$I_{F(AV)} : 15A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.59V$$

电特性:

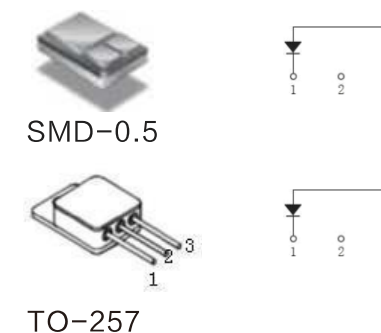
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 15A, $T_J = -55^\circ C$
		0.59		@ 15A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	12	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S20

$$I_{F(AV)} : 20A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.56V$$

电特性:

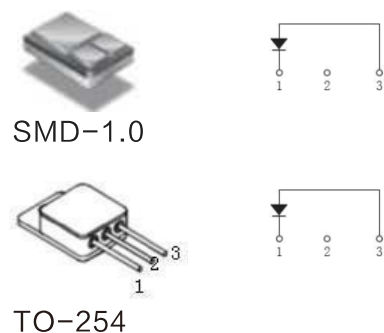
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 20A, $T_J = -55^\circ C$
		0.56		@ 20A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	40	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S30

$$I_{F(AV)} : 30A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.55V$$

电特性:

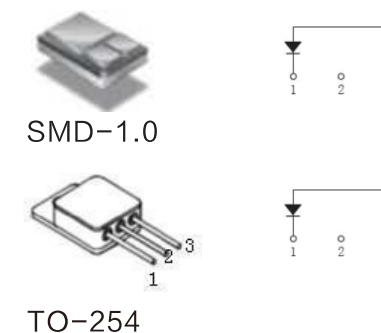
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@30A, $T_J = -55^\circ C$
		0.55		@30A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S60 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S60

$$I_{F(AV)} : 60A$$

$$V_{RMM} \geq 45V$$

$$V_F \leq 0.57V$$

电特性:

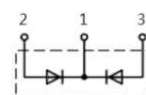
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@60A, $T_J = -55^\circ C$
		0.57		@60A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 45V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S1 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S1

$$I_{F(AV)} : 1A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.5V$$

电特性:

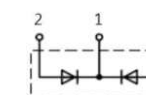
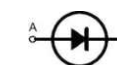
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.6	V	@ 1A, $T_J = -55^\circ C$
		0.5		@ 1A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	35	uA	$V_R = 60V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S3 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S3

$$I_{F(AV)} : 3A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.61V$$

电特性:

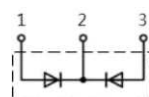
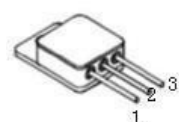
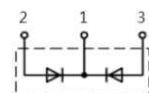
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 3A, $T_J = -55^\circ C$
		0.61		@ 3A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	8	uA	$V_R = 60V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S5

$$I_{F(AV)} : 5A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.5V$$

电特性:

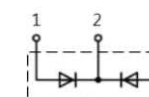
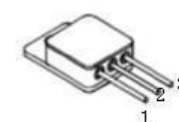
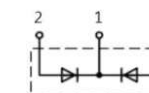
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@5A, $T_J = -55^\circ C$
		0.5		@5A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	100	uA	$V_R = 60V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 60V T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S10

$$I_{F(AV)} : 10A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.66V$$

电特性:

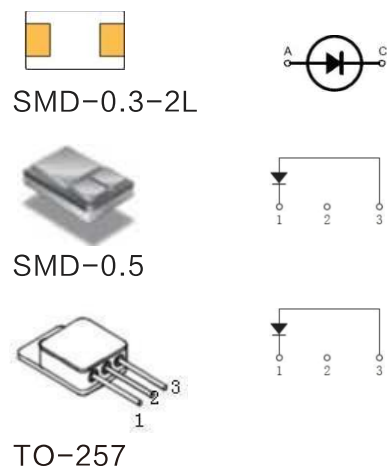
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@10A, $T_J = -55^\circ C$
		0.66		@10A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 60V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S15 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S15

$$I_{F(AV)} : 15A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.72V$$

电特性:

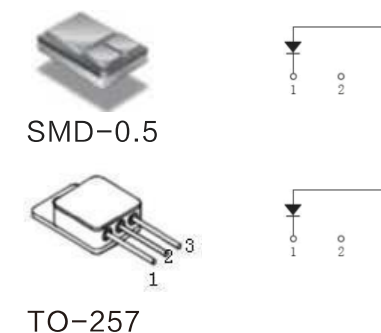
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.85	V	@ 15A, $T_J = -55^\circ C$
		0.72		@ 15A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	10	uA	$V_R = 60V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S20

$$I_{F(AV)} : 20A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.67V$$

电特性:

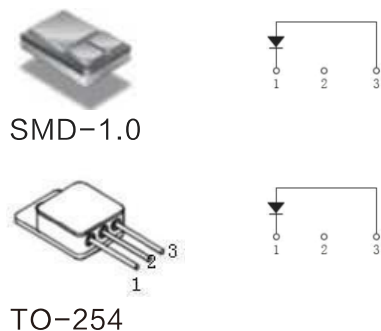
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 20A, $T_J = -55^\circ C$
		0.67		@ 20A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 60V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S30

$$I_{F(AV)} : 30A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.67V$$

电特性:

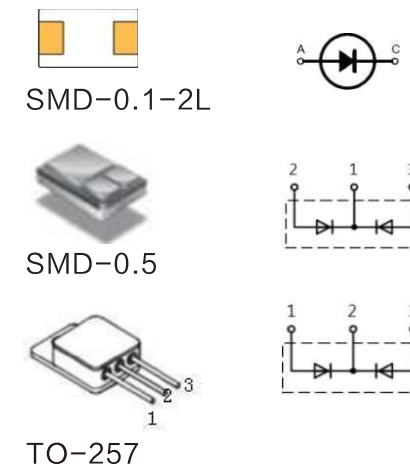
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 30A, $T_J = -55^\circ C$
		0.67		@ 30A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 60V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V T_J = 125^\circ C$

JXCCS100S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS100S5

$$I_{F(AV)} : 5A$$

$$V_{RMM} \geq 100V$$

$$V_F \leq 0.78V$$

电特性:

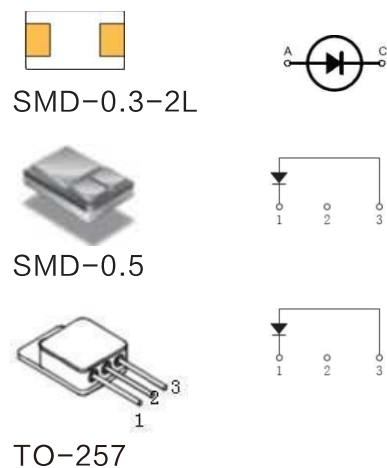
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 5A, $T_J = -55^\circ C$
		0.78		@ 5A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	300	uA	$V_R = 100V T_J = 25^\circ C$
		1000		$V_R = 100V T_J = 125^\circ C$

JXCCS100S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS100S10

$$I_{F(AV)} : 10A$$

$$V_{RMM} \geq 100V$$

$$V_F \leq 0.76V$$

电特性:

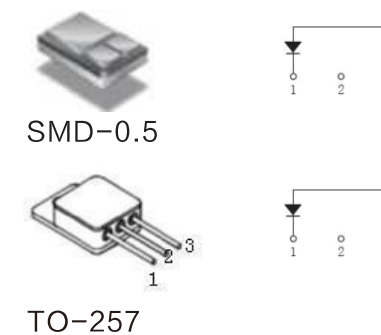
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.85	V	@ 10A, $T_J = -55^\circ C$
		0.76		@ 10A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	10	uA	$V_R = 100V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 100V T_J = 125^\circ C$

JXCCS100S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS100S20

$$I_{F(AV)} : 20A$$

$$V_{RMM} \geq 100V$$

$$V_F \leq 0.74V$$

电特性:

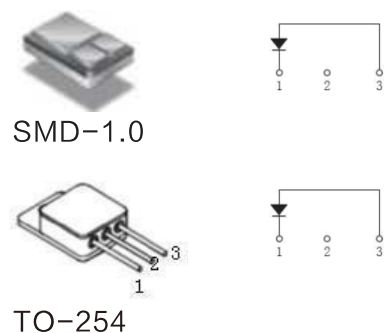
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.85	V	@ 20A, $T_J = -55^\circ C$
		0.74		@ 20A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	50	uA	$V_R = 100V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 100V T_J = 125^\circ C$

JXCCS100S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS100S30

$$I_{F(AV)} : 30A$$

$$V_{RMM} \geq 100V$$

$$V_F \leq 0.87V$$

电特性:

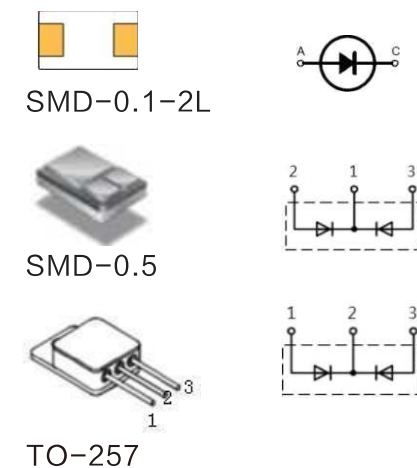
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@30A, $T_J = -55^\circ C$
		0.87		@30A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	150	uA	$V_R = 100V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 100V T_J = 125^\circ C$

JXCCS150S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS150S5

$$I_{F(AV)} : 5A$$

$$V_{RMM} \geq 150V$$

$$V_F \leq 0.8V$$

电特性:

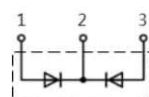
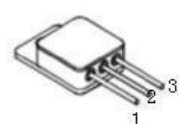
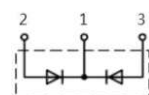
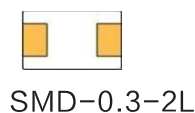
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@5A, $T_J = -55^\circ C$
		0.8		@5A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	20	uA	$V_R = 150V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 150V T_J = 125^\circ C$

JXCCS150S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS150S10

$$I_{F(AV)} : 10A$$

$$V_{RMM} \geq 150V$$

$$V_F \leq 0.81V$$

电特性:

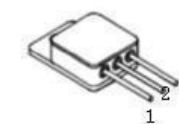
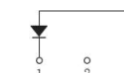
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 10A, $T_J = -55^\circ C$
		0.81		@ 10A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	10	uA	$V_R = 150V T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 150V T_J = 125^\circ C$

JXCCS150S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS150S20

$$I_{F(AV)} : 20A$$

$$V_{RMM} \geq 150V$$

$$V_F \leq 0.8V$$

电特性:

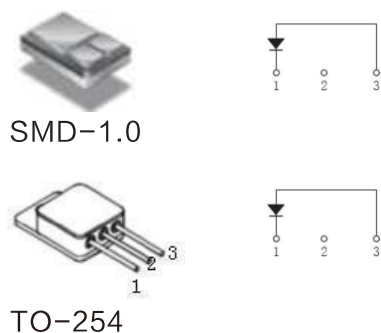
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 20A, $T_J = -55^\circ C$
		0.8		@ 20A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	50	uA	$V_R = 150V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 150V T_J = 125^\circ C$

JXCCS150S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS150S30

$$I_{F(AV)} : 30A$$

$$V_{RMM} \geq 150V$$

$$V_F \leq 0.84V$$

电特性:

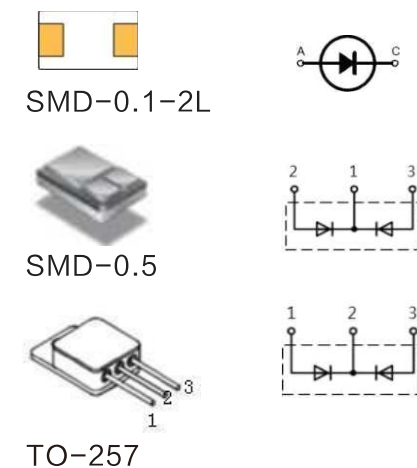
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@30A, $T_J = -55^\circ C$
		0.84		@30A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	50	uA	$V_R = 150V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 150V T_J = 125^\circ C$

JXCCS200S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS200S5

$$I_{F(AV)} : 5A$$

$$V_{RMM} \geq 200V$$

$$V_F \leq 0.85V$$

电特性:

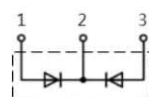
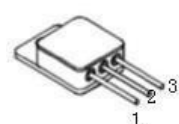
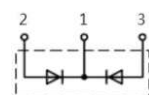
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@5A, $T_J = -55^\circ C$
		0.85		@5A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	4	uA	$V_R = 200V T_J = 25^\circ C$
		100		$V_R = 200V T_J = 125^\circ C$

JXCCS200S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS200S10

$$I_{F(AV)} : 10A$$

$$V_{RMM} \geq 200V$$

$$V_F \leq 0.84V$$

电特性:

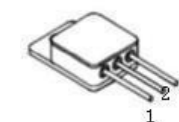
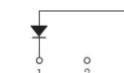
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 10A, $T_J = -55^\circ C$
		0.84		@ 10A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	8	uA	$V_R = 200V T_J = 25^\circ C$
		100		$V_R = 200V T_J = 125^\circ C$

JXCCS200S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS200S20

$$I_{F(AV)} : 20A$$

$$V_{RMM} \geq 200V$$

$$V_F \leq 0.82V$$

电特性:

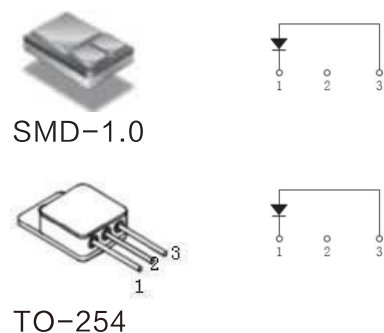
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 20A, $T_J = -55^\circ C$
		0.82		@ 20A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	15	uA	$V_R = 200V T_J = 25^\circ C$
		100		$V_R = 200V T_J = 125^\circ C$

JXCCS200S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS200S30

$$I_{F(AV)} : 30A$$

$$V_{RMM} \geq 200V$$

$$V_F \leq 0.85V$$

电特性:

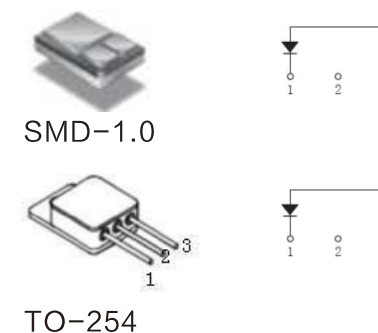
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@30A, $T_J = -55^\circ C$
		0.85		@30A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	1.5	uA	$V_R = 200V T_J = 25^\circ C$
		100		$V_R = 200V T_J = 125^\circ C$

JXCCS200S40 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS200S40

$$I_{F(AV)} : 40A$$

$$V_{RMM} \geq 200V$$

$$V_F \leq 0.87V$$

电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@40A, $T_J = -55^\circ C$
		0.87		@40A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	150	uA	$V_R = 200V T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 200V T_J = 125^\circ C$